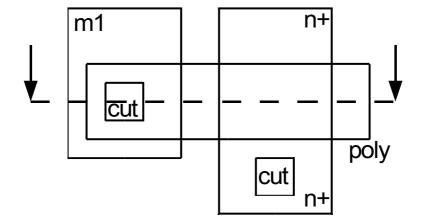
## **EEM411 DERSİ 1. KISASINAV SORULARI**

- 1. CMOS üretim sürecinde MOSFET'lerin drain ve source bölgelerinin oluşumunda etkin olan maske hangisidir? **ACTIVE**
- 2. MOSFET kanal uzunluğu (L) hangi maske ile belirlenir? POLY
- 3. MOSFET substrate oluşumu hangi maske ile belirlenir? WELL
- 4. CMOS üretim sürecinde GateOxide uygulaması sonrası hangi maske uygulanır? POLY
- 5. CMOS üretim sürecinde belirli bölgelerdeki Oxit tabakasının X-Maskesi ile kaldırılması isteniyor. Uygulanacak işlemleri sırasıyla yazınız.

Fotoresist kapla, X-Mask yerleştir, UV light uygula, fotoresist develop et, asit ile erit, fotoresist kaldır/erit.

6. Aşağıdaki serimde belirtilen kesit çizgisine egöre serimin kesit çizimini yapınız.



## Aşağıdadır:

